

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0497U004334

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 17-04-1998

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Горин Андрей Евгеньевич

2. Горин Андрей Евгеньевич

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: dashboard/okd.okd_type_names.0

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 01.04.10

Назва наукової спеціальності: Фізика напівпровідників і діелектриків

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 12-03-1997

Спеціальність за освітою: 0629

Місце роботи здобувача: Інститут фізики напівпровідників НАН України

Код за ЄДРПОУ: 05416952

Місцезнаходження: 252022,Київ-22, пр. Науки, 45

Форма власності:

Сфера управління: НАН України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 04.04.08

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію

Повне найменування юридичної особи: Інститут фізики напівпровідників НАН України

Код за ЄДРПОУ: 05416952

Місцезнаходження: 252022, Київ-22, пр. Науки, 45

Форма власності:

Сфера управління: НАН України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 47.09.29

Тема дисертації:

1. Исследование анизотропии тензорезистивных эффектов в сильно деформированных кристаллах Ge и Si
- 2.

Реферат:

1. Объект исследования: Закономерности и механизмы кинетических явлений, обусловленных анизотропией энергетического спектра и анизотропией рассеивания носителей заряда в сильно деформированных кристаллах n-Ge, p-Ge, n-Si, p-Si. Цель исследования: Проведение экспериментальных исследований для анализа кинетических явлений в условиях перестройки энергетической зонной структуры и влияния таких физических факторов, как: сильные направленные давления, сильные электрические поля, низкие температуры, большие дозы гамма-облучения, а также идентификация физических механизмов тэнзоэффектов. Методы исследования и аппаратура: Лабораторная автоматизированная установка для исследований тэнзорезистивных свойств полупроводников в условиях сильных направленных деформаций, вычислительный комплекс "ВУМС 128-013", "КАМАК". Теоретические результаты и новизна: Установлено, что в случае низкотемпературной ударной ионизации мелких примесей в n-Ge функция распределения носителей тока по энергии принимает сильно анизотропный вид-возникает стриминг. Практические результаты и новизна: Исследования тэнзорезистивных эффектов в кристаллах Ge и Si позволил определить

возможности повышения чувствительности, расширения температурного апазона и диапазона по давлению чувствительных элементов датчиков давления. Предмет и степень внедрения: Результаты исследований дают возможность определить физические механизмы тэнзоэффектов, что в свою очередь, может быть использовано для оптимизации характеристик датчиков давления. Эффективность внедрения: использование результатов определяет возможность разработки датчиков давления с такими параметрами: нелинейность рабочей характеристики <0.1; чувствительность до 25-30 мВ/В*бар; температурный диапазон функционирования 200 К-450 К. Сфера (область) использования: Проект УНТЦ; производство интегральных датчиков давления.

2.

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Підсумки дослідження:

Публікації:

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації:

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Коломоец В.В.

2. Коломоец В.В.

Кваліфікація: д.ф.-м.н., 01.04.10

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Буджак Я.С.
2. Буджак Я.С.

Кваліфікація: д.ф.-м.н., 01.04.02

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Савчын В.П.
2. Савчын В.П.

Кваліфікація: 01.04.10

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові
голови ради**

Вакарчук І.О.

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові
головуючого на засіданні**

Вакарчук І.О.

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Реєстратор

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності**



Юрченко Т.А.